

P3500

硅 PNP 外延平面功率晶体管芯片 (4 ")

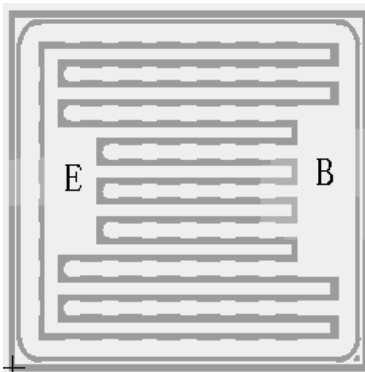
■用途:

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 N3500 配对
- *有效图形数 600 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	3450 μ m \times 3450 μ m
压焊区尺寸	基区: 540 μ m \times 1655 μ m 发射区: 500 μ m \times 1240 μ m
芯片厚度	270 \pm 20 μ m
锯片槽宽度	100 μ m
金属层	正面:Al 4 \pm 0.4 μ m 背面:Ag 1.4 \pm 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -100 \mu A, I_E = 0$	-80	-100	-150	-180	-220		V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -50 mA, I_B = 0$	-60	-80	-120	-150	-200		V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E = -100 \mu A, I_C = 0$	-7						V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = 0.9 BV_{CBO}, I_E = 0$						-1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -10V, I_C = 0$						-1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	65					350	
集电极-发射极饱和电压	V_{CESAT}	$I_C = -5A, I_B = -0.5A$						-2.0	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	10						MHz